

关键指标

- 频率: DC~4GHz
- 插入损耗: 0.5dB
- 隔离度: 43dB
- 控制电平: 0/+5V 或 0/-5V
- 芯片尺寸: 0.75mm×0.6mm×0.1mm

产品简介

HG123KB 是一款 DC~4GHz 反射式单刀双掷开关芯片, 插入损耗为 0.3dB, 隔离度为 43dB。

电性能 (T_A=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~4		
输入驻波	-	1.1	-
输出驻波	-	1.1	-
插入损耗(dB)	-	0.5	-
隔离度(dB)	-	43	-

真值表 (两种控制方式任选其一)

正电控制真值表

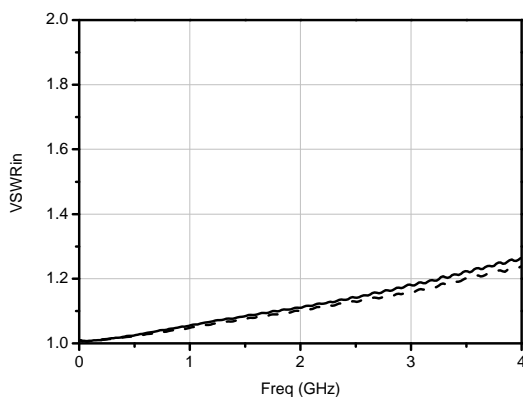
SW1	SW2	RFC to RF1	RFC to RF2
5V	0V	ON	OFF
0V	5V	OFF	ON

负电控制真值表

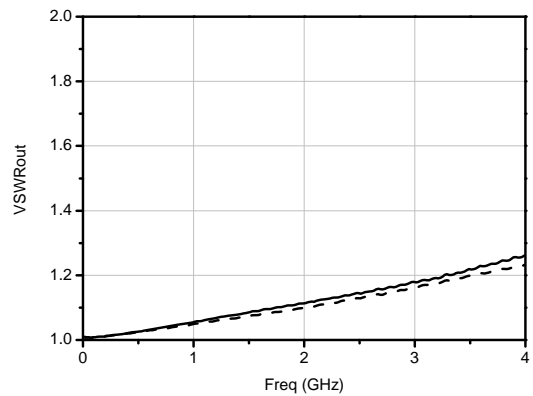
SW1	SW2	RFC to RF1	RFC to RF2
0V	-5V	ON	OFF
-5V	0V	OFF	ON

典型测试曲线

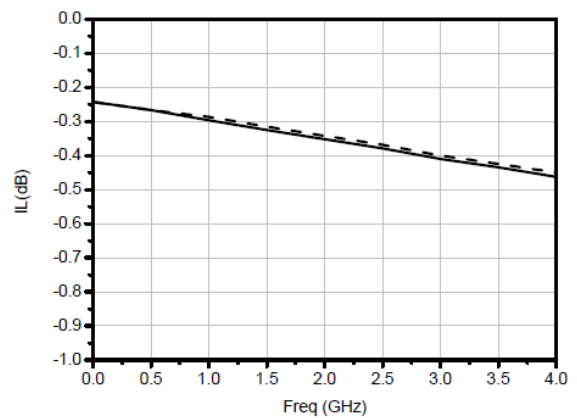
输入驻波



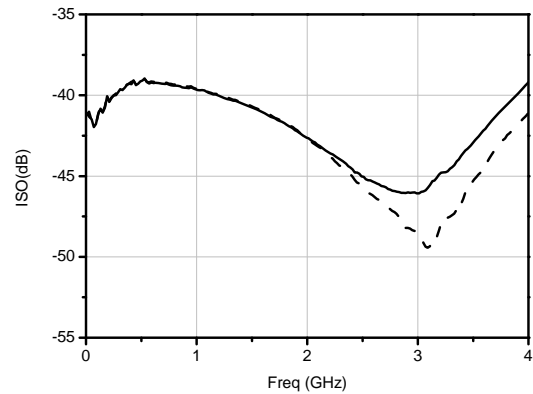
输出驻波



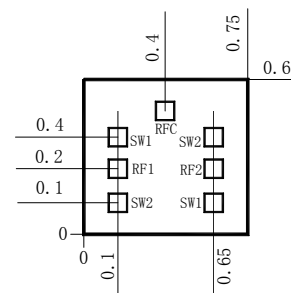
插入损耗



隔离度



外形和端口尺寸 (mm)



绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
控制电平	±5.5V
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。